

ABSTRACT OF THE DISCLOSURE

皮膜除去工程、研磨工程、及び洗浄工程を包含するシリコンウエハーの再生方法において、皮膜除去工程と研磨工程の間に、シリコンウエハーを150～300℃で20分間～5時間加熱し、更に、シリコンウエハー表面部を除去する加熱・除去工程を含むことを特徴とするシリコンウエハーの再生方法である。

本発明によれば、シリコンウエハーの表面のみならず内部に侵入したCuを取除き、シリコンウエハー内部についてもCu汚染がない、シリコンウエハーの再生方法を提供することができるので、極めて有用である。